

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Якимов Евгений Борисович
2	Дата рождения (полная)	17 ноября 1947
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук (специальность 01.04.10)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	142432, Московская область, Черноголовка, ул.Институтская, д.6 http://www.iptm.ru eagle@iptm.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
	Ведомственная принадлежность организации	РАН
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов
	Должность	Заведующий лабораторией
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<ol style="list-style-type: none"> Orlov, V.I., Vergeles, P.S., Yakimov, E.B., Li, X., Yang, J., Lv, G., Dong, S., Estimations of Low Temperature Dislocation Mobility in GaN, Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, Volume 216, Issue 17, 1 September 2019 Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Yakimov E.B., Tarelkin S.A., Turutin A.V., Shemerov I.V., Pearton S.J., Bae K.B., Lee I.H. Deep traps determining the non-radiative lifetime and defect band yellow luminescence in n-GaN. Journal of alloys and compounds, 686 C.1044-1052 (2016) Yakimov, E.B., Estimation of the Maximum Nonequilibrium Charge-Carrier Concentration in GaN Under Electron-Beam Irradiation, Journal of Surface Investigation, Volume 12, Issue 5, 1 September 2018, Pages 1000-1004 Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Yakimov E.B., Lee I.H., Pearton S.J. Electrical, luminescent, and deep trap properties of Si doped n-GaN grown by pendeo epitaxy. Journal Of Applied Physics, 119 (1) C.015103 (2016) Yakimov E.B. What is the real value of diffusion length in GaN? Journal of Alloys and Compounds, 627 C.344-351 (2015) Малин Т.В., Гилинский А.М., Мансуров В.Г., Протасов Д Ю., Шестаков А.К., Якимов Е.Б., Журавлев К.С. Синтез AlGaIn/GaN-гетероструктур для ультрафиолетовых фотоприемников методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Журнал технической физики, 85 (4) С.67-73 (2015) Vergeles, P.S., Orlov, V.I., Polyakov, A.Y., Yakimov, E.B., Kim, T., Lee, I.-H., Recombination and optical properties of dislocations gliding at room temperature in GaN under applied stress, Journal of Alloys and Compounds, Volume 776, 5 March 2019, Pages 181-186 Lee, I.-H., Polyakov, A.Y., Smirnov, N.B., Shchemerov, I.V., Lagov, P.B., Zinov'Ev, R.A., Yakimov, E.B., Shcherbachev, K.D., Pearton, S.J., Point defects controlling non-radiative recombination in GaN blue light emitting diodes: Insights from radiation 	

	damage experiments, Journal of Applied Physics, Volume 122, Issue 11, 21 September 2017	
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)	
9	Адрес электронной почты	